

## 第 1 章 芯片简介

### 1.1 概述

#### ■ 内核

- 8051 内核
- 系统时钟 4Mhz
- 支持中断处理，支持中断优先级和中断向量表

#### ■ 存储资源

- 8K\*8bit ROM
- 256\*8bit SRAM 数据存储器

#### ■ I/O 端口

- 最多支持 12 个 I/O

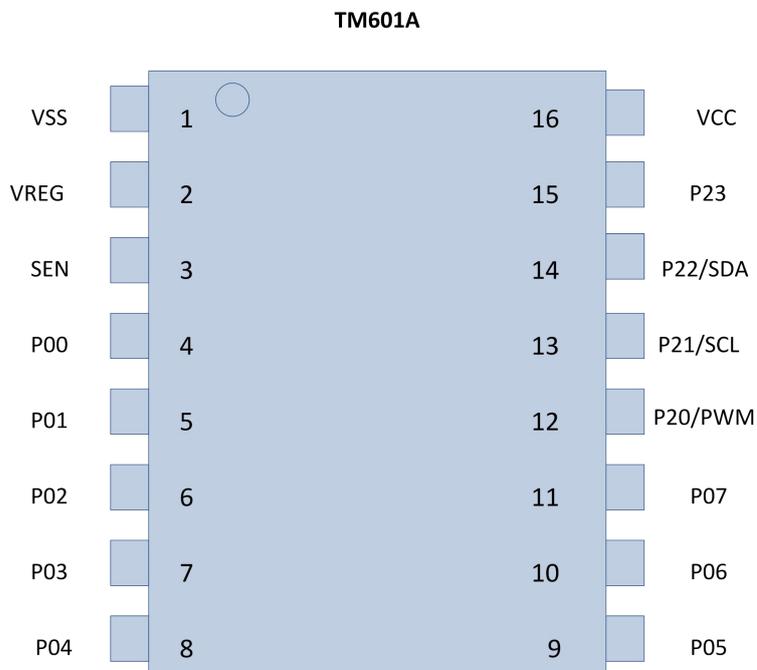
◇P0 端口 (P00~P07): P00~P03 可以配置为输出管脚, P04~P07 可以配置为 IO 端口。P0 端口还可以配置为 8 按键触摸输入。

◇P2 端口 (P20~P23): P20~P23 可以配置为普通 IO。P20 还可以配置为 PWM 输出, P21P22 可以配置为 SCL, SDA 端口, 支持 I2C 的 slave 模式通信。

#### ■ 工作条件

- 2.8V~5.5V
- 20~85°C

### 1.2 管脚图



## 第 2 章 电气特性及封装

### 额定值 \*

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度	-50 ~ +150°C
电源电压	-0.3 ~ +6.5V
管脚最大电流	±20mA
管脚电压	-0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts

\* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏

### 电气特性

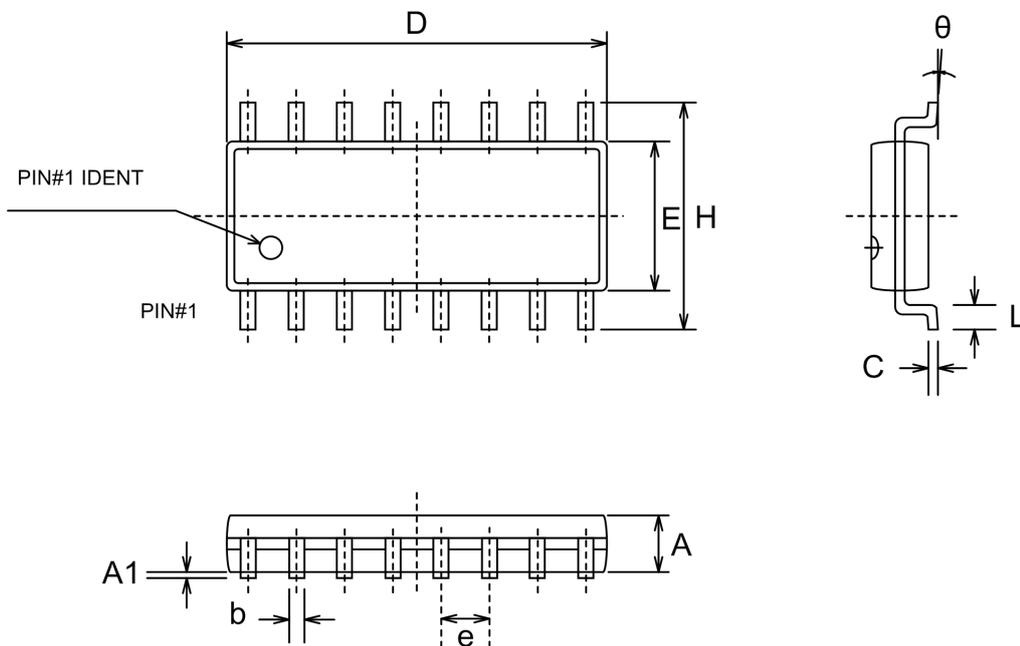
TA = 25°C

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc		2.5		5.5	V
电流消耗	I <sub>dd</sub>	VCC=5.0V		2		mA
		VCC=3.0V		1		mA
		VCC=5.0V &SLEEP		8		UA
		VCC=3.0V &SLEEP		5		UA
输出阻抗 (开漏输出)	Z <sub>o</sub>	低电平		50		Ohm
		高阻		100M		
输出灌电流	I <sub>sk</sub>	VCC=5V			10.0	mA

### ESD特性

模式	极性	最大值	参考
H.B.M	POS/NEG	8000V	VDD
		8000V	VSS
		8000V	P to P
M.M	POS/NEG	500V	VDD
		500V	VSS
		500V	P to P

封装尺寸图 (S0-16)



Symbol	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	9.70	10.00	10.30	0.382	0.394	0.406
E	3.75	3.95	4.15	.0148	0.156	0.163
e	--	1.27	--	--	0.050	--
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
$\theta$	0°	--	8°	0°	--	8°